

عنوان مقاله:

تأثیر گرادیان ضخامت خطی بر بلور فوتونی گرافنی تنظیم پذیر در ناحیه تراهرتز

محل انتشار:

دوفصلنامه اپتوالکترونیک، دوره ۳، شماره ۱ (سال: ۱۳۹۹)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسنده‌گان:

مرضیه رنجبر - مربی، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور

علیرضا جنگجو - مرکز تکنولوژی پیشرفته امواج فوتونی کوستیک، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه تورنتو، تورنتو،

خلاصه مقاله:

با استفاده از روش ماتریس انتقال، خواص اپتیکی دو ساختار بلور فوتونی تنظیم پذیر یک بعدی بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. ساختار بلور فوتونی اول شامل لایه های متناوب دو دی الکتریک SiO₂ و Si است که لایه های گرافنی بین لایه های دی الکتریک قرار گرفته اند. با افزودن پلیمر پلی استایرن به عنوان لایه نقص به ساختار بلور فوتونی، مد نقص در محدوده نوار گاف فوتونی ظاهر می شود. این مد نقص با پتانسیل شیمیایی گرافن و زاویه موج فروندی تنظیم پذیر است. در ساختار بلور فوتونی دوم، یکی از لایه های دی الکتریک ساختار بلوری اول دارای گرادیان خطی است. مد نقص برای سه ساختار با گرادیان های ضخامت خطی متفاوت رسم شده و با حالت فاقد گرادیان مقایسه شده است. مکان مدهای نقص در ساختار بلور با گرادیان خطی در مقایسه با حالت فاقد گرادیان به سمت فرکانس های کمتر جابجا می شوند. در هر دو ساختار تأثیر پتانسیل شیمیایی گرافن و زاویه فروندی موج قطبیده TE و TM بر تنظیم پذیری مکان مد نقص و نوار گاف فوتونی و نوار گاف فوتونی گرافنی بررسی شده است. با افزایش پتانسیل شیمیایی گرافن و زاویه موج فروندی مکان مد نقص به سمت فرکانس های بیشتر جایه جا می شود. از این دو ساختار می توان در طراحی فیلترهای تراهرتز قابل تنظیم استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

بلور فوتونی گرافنی یک بعدی، فیلتر تنظیم پذیر، پلیمر پلی استایرن، ناحیه تراهرتز

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1844912>